

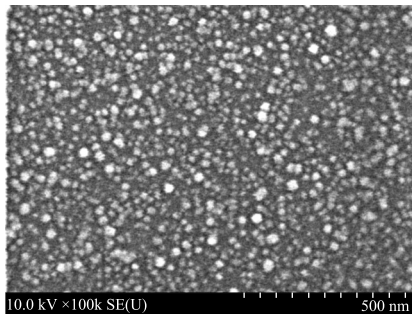
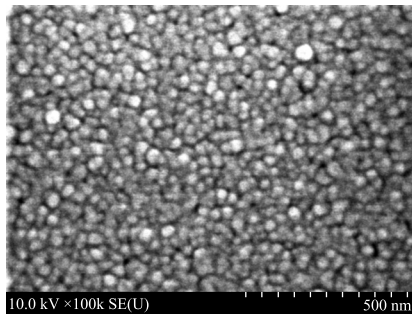
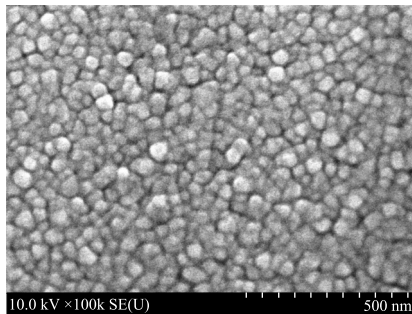
a/a*б/б**в/в*

Рис. 4. РЭМ-изображения (увеличение $\times 100\,000$) микрорельефа поверхности зародышевого слоя $\text{Si}_{1-x}\text{Ge}_x$, осажденного на монокремний при температуре $570\text{ }^\circ\text{C}$.

Длительность осаждения: *а* – 180 с; *б* – 300 с; *в* – 420 с

Fig. 4. SEM image (magnification $\times 100\,000$) of the surface microrelief of the $\text{Si}_{1-x}\text{Ge}_x$ seed layer deposited on monosilicon at a temperature of $570\text{ }^\circ\text{C}$.

Deposition times: *a* – 180 s; *b* – 300 s; *c* – 420 s